

2.1 Dioden

2.1.1 Grundlagen

Eigenleitung

Die uns interessierenden Halbleitermaterialien sind Kristallstrukturen. Ein absolut reiner Halbleiterkristall, z. B. ein Stück Reinstsilizium, leitet bei tiefen Temperaturen praktisch keinen Strom. Es stehen einfach keine Ladungsträger zur Verfügung, da alle Elektronen in den Atomen des Kristallgitters gebunden sind. Wärme oder Licht versetzen die Atome in Schwingungen. Dadurch werden einige Elektronen aus dem Verband herausgelöst, so daß Strom fließen kann. Die herausgelösten Elektronen hinterlassen buchstäblich "Löcher" (Holes) in den Kristallbindungen. Diese sind logischerweise Träger einer positiven Ladung. Ein solches Loch kann von einem Elektron besetzt werden, das dann seinerseits ein Loch hinterläßt. Den Vorgang, daß ein Elektron eine Loch-Position besetzt, nennt man Rekombination.

Obwohl ein Loch (andere Bezeichnungen: Fehlstelle, Störstelle, Defektelektron) nichts Gegenständliches ist, kann man es als Träger positiver Ladung ansehen und mit den entsprechenden Ladungsträger-Kennwerten rechnen. So entsprechen Masse und Ladungsmenge eines Loches der eines Elektrons (nur hat die Ladungsmenge ein umgekehrtes Vorzeichen). Elektronen fließen von Minus nach Plus, Löcher von Plus nach Minus. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Löchern ist aber viel geringer als die von Elektronen (das ist die physikalische Ursache dafür, daß man für NPN-Transistoren weniger Silizium braucht als für PNP-Transistoren mit vergleichbaren Kennwerten).

Dotierung

Um mit Halbleitern Gleichrichter- und Verstärkerwirkung zu erbringen, ist die Eigenleitung nicht ausreichend. Man muß vielmehr den Leitungsmechanismus gezielt beeinflussen. Dies erreicht man durch Beimischungen von Atomen anderer Wertigkeit (Dotierung). Hat ein solches Atom eine höhere Wertigkeit, so können nicht alle seine Bindungselektronen in den Kristallverband eingebaut (und somit neutralisiert) werden. Somit ist ein Überschuß an Elektronen vorhanden, der verfügbar ist, um Strom zu leiten (Elektronen- oder N-Leitung). Hat ein solches Atom hingegen eine geringere Wertigkeit, so fehlen an den Bindungsstellen des Kristalls Elektronen. Somit ist ein Überschuß an Löchern vorhanden, der ebenfalls zur Stromleitung nutzbar ist (Löcher- oder P-Leitung).

Eine Dotierung, die einen Elektronenüberschuß erzeugt, heißt Donator-Dotierung, eine, die einen Überschuß an Löchern erzeugt, Akzeptor-Dotierung. Die Ladungsträger, die infolge der Dotierung vorherrschen, heißen Majoritätsträger, die jeweils anderen Minoritätsträger.

Bei Silizium als Halbleiter-Grundwerkstoff bestehen Donator-Dotierungen aus 5-wertigen Atomen (z. B. Antimon Sb oder Phosphor P) und Akzeptor-Dotierungen aus dreiwertigen (z. B. Bor B oder Gallium Ga). Silizium selbst ist vierwertig. Abbildung B5-1.55 zeigt, wie durch Dotierung einer Kristallstruktur N-leitende und P-leitende Halbleiterschichten erzeugt werden.

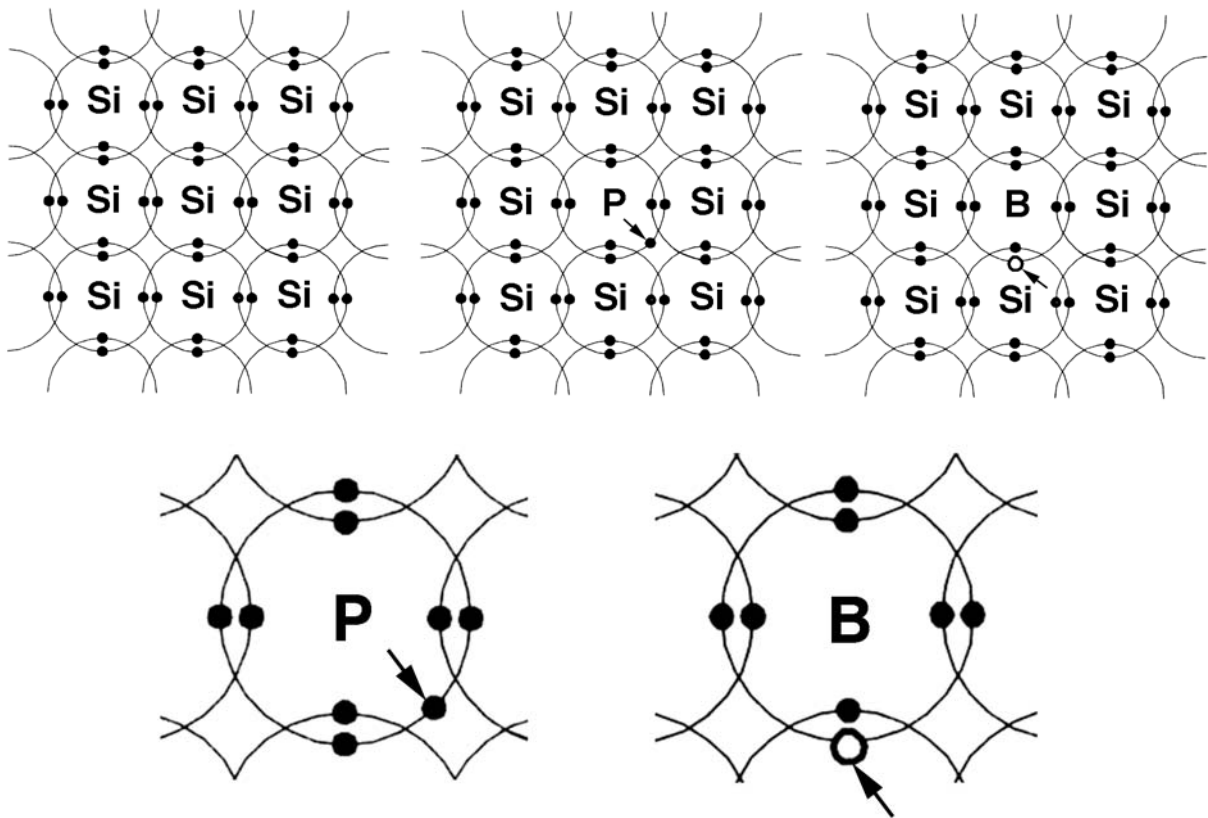
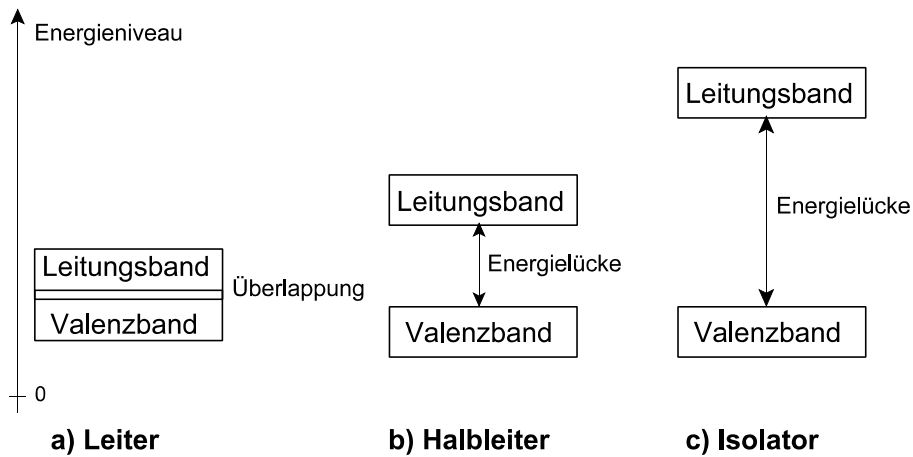


Abbildung 2.1.1 Dotierung eines Halbleiterkristalls. a) ein reiner Siliziumkristall. Alle Valenzelektronen der Atome sind in Doppelbindungen (kovariante Bindungen) einbezogen. b) N-Leitung durch Einbau eines fünfwertigen Atoms (z. B. Phosphor P), c) P-Leitung durch Einbau eines dreiwertigen Atoms (z. B. Bor B).

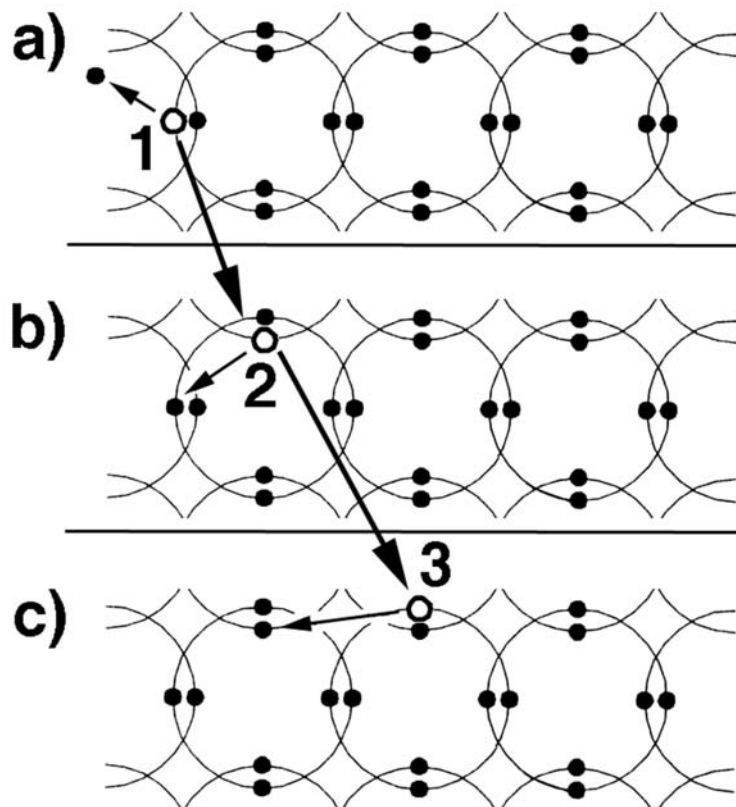


Abbildung 2.1.2 Prinzip der Löcherleitung. Löcher an sich können sich nicht bewegen – auch hier sind es eigentlich die Elektronen. a), b) und c) zeigen die gleichen Atome zu verschiedenen Zeitpunkten. a) Elektron 1 verläßt seinen Platz in einer Doppelbindung; es ergibt sich das erste Loch. b) Elektron 2 verläßt seinen Platz in einer Doppelbindung und fällt gleichsam in die Position des Lochs 1 (Rekombination). c) Loch 2 wird von Elektron 3 gefüllt, das einerseits seinen Platz in einer Doppelbindung verlassen hat. Infolge dieser Elektronenbewegung scheint es so, als ob ein Loch von Position 1 über Position 2 nach Position 3 gewandert ist.

Der PN-Übergang

Ein PN-Übergang entsteht, wenn ein Stück Halbleitermaterial auf einer Seite eine Akzeptor-Dotierung und auf der anderen eine Donator-Dotierung erhält, so daß eine P-leitende Zone einer N-leitenden unmittelbar gegenübersteht (Abbildung B5-1.56). Legt man eine Spannungsquelle mit dem Pluspol an die P-leitende Zone und mit dem Minuspol an die N-leitende, so werden die Elektronen zum Pluspol und die Löcher zum Minuspol fließen (gleichnamige Pole stoßen einander ab; die jeweiligen Majoritätsträger werden also buchstäblich aufeinander zugedrückt). Im eigentlichen Übergangsbereich treffen Elektronen und Löcher aufeinander und rekombinieren. Es fließt also tatsächlich ein Strom. Legt man hingegen die Spannungsquelle mit dem Pluspol an die N-leitende Zone und mit dem Minuspol an die P-leitende, so werden die Majoritätsträger förmlich zu den Anschlüssen der Spannungsquelle hingesaugt (ungleichnamige Pole ziehen einander an). Der eigentliche Übergangsbereich ist somit weitgehend frei von Ladungsträgern, so daß kein nennenswerter Strom fließen kann (Sperrschicht).

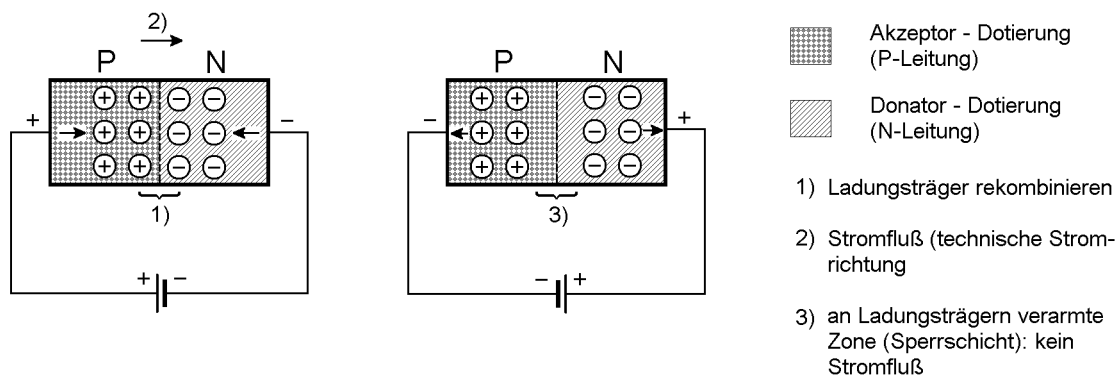


Abbildung 2.1.3 Der PN-Übergang. Links: Betrieb in Durchlaßrichtung, rechts: Betrieb in Sperrrichtung

Dioden

Dioden sind passive Halbleiterbauelemente mit zwei Anschlüssen. Der eine Anschluß heißt Katode, der andere Anode. Die ideale Diode wirkt wie ein Schalter, dessen Stellung davon bestimmt wird, an welchem der beiden Anschlüsse das positivere und an welchem das negativere Potential anliegt:

- liegt an der Katode eine negativere und an der Anode eine positivere Spannung an, so ist der Schalter geschlossen: die Diode ist *leitend* bzw. in *Durchlaß- oder Flußrichtung* geschaltet; es kommt ein Stromfluß zustande,
- liegt an der Katode eine positivere und an der Anode eine negativere Spannung an, so ist der Schalter geöffnet: die Diode ist *gesperrt* bzw. in *Sperrrichtung* geschaltet; es kann kein Strom fließen.

In Kurzform:

- Durchlaßrichtung (Forward Direction) = Minus an Katode, Plus an Anode,
- Sperrrichtung (Reverse Direction) = Plus an Katode, Minus an Anode.

Es können verschiedene physikalische Effekte und verschiedene Materialien genutzt werden, um derart wirkende Bauelemente zu schaffen. Die meisten modernen Dioden beruhen jedoch auf dem PN-Übergang (üblicherweise als *Sperrschicht* bezeichnet) und auf Silizium als Basismaterial. Abbildung 2.1.1 veranschaulicht die Grundlagen.

Die Diode

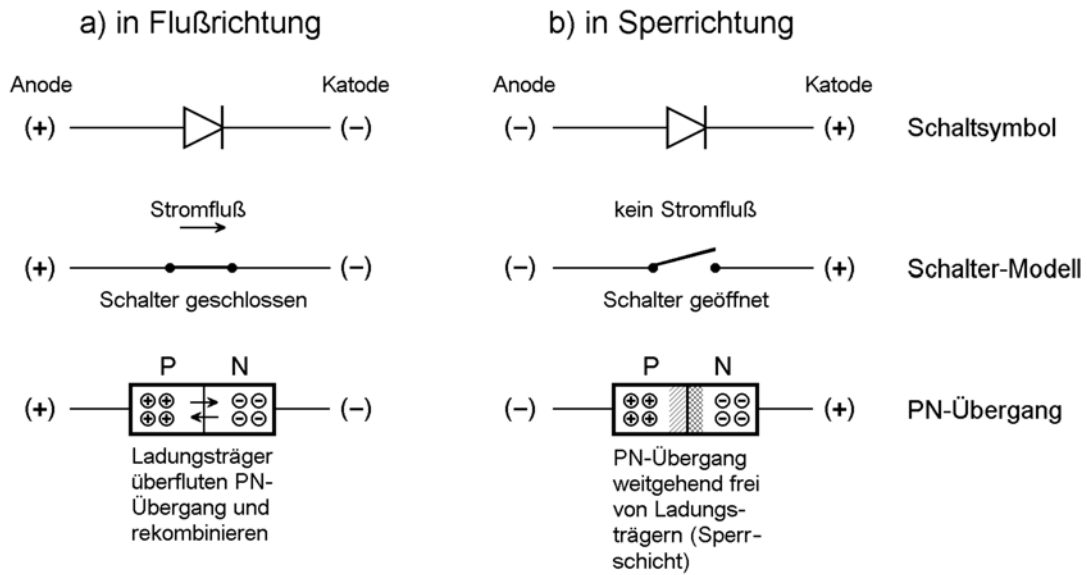


Abbildung 2.1.4 Die (idealisierte) Halbleiterdiode

2.1.1.1 Die Diode in der Kennlinie

Das einfache Schaltermodell ist für die Praxis zu ungenau. Um die wesentlichen Einzelheiten zu erkennen, müssen wir uns die Strom-Spannungs-Kennlinie der Diode ansehen (Abbildung 2.1.2).

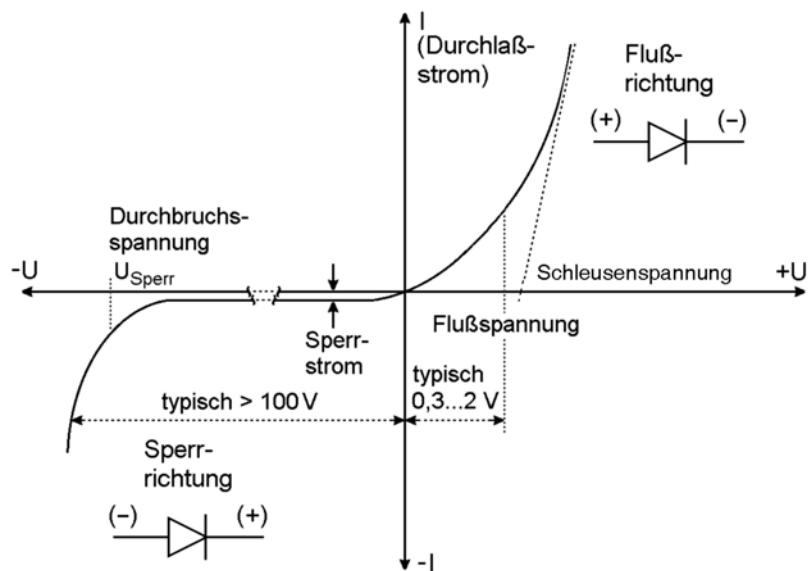


Abbildung 2.1.5 Diodenkennlinie

Gleichung der Diodenkennlinie:

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1 \right) \approx I_S \cdot e^{\frac{U}{nU_T}}$$

Temperaturspannung $U_T = \frac{kT}{q}$

$k =$ Boltzmannkonstante $1,38 \cdot 10^{-23} \frac{Ws}{K}$

$T =$ Temperatur in K

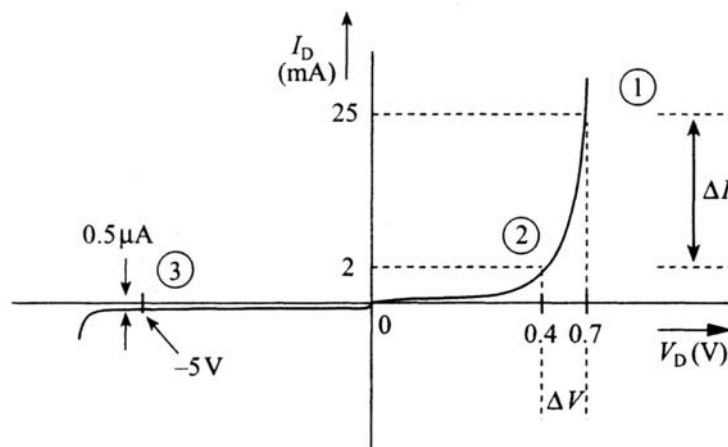
$q =$ Elementarladung $e = 0,16021892 \cdot 10^{-18} C$

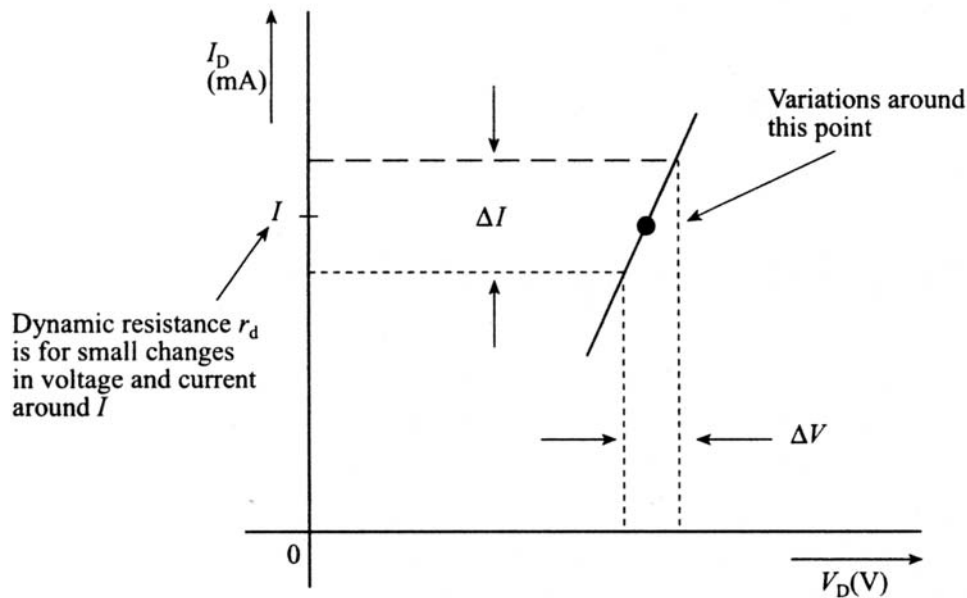
$n =$ Anpassungsfaktor (Erfahrungswert).

Bei Zimmertemperatur gilt:

- bei 20 °C: $U_T \cdot 25 \text{ mV}$,
- bei 25 °C: $U_T \cdot 26 \text{ mV}$.

	Spannungsbereich	n
Germanium	-	1
Silizium	$U \# U_s$	2
Silizium	$U > U_s$	1





Dynamischer Widerstand :

$$\frac{dI}{dU} = \frac{e}{kT} \cdot I \cdot e^{\frac{eU}{kT}}$$

$$r_d = \frac{dU}{dI} = \frac{kT}{e} \cdot \frac{1}{I_s \cdot e^{\frac{eU}{kT}}} \approx \frac{U_T}{I}$$

$$r_d \approx \frac{0,026V}{I}$$

Temperaturabhängigkeit (Silizium):

- für je 1 ° Temperaturanstieg fällt die Schleusenspannung um 2 mV,
- für je 10° Temoeraturanstieg verdoppelt sich der Sperrstrom.

Die Durchlaßrichtung

Wenn, von Wert 0 an beginnend, die Spannung an der Anode - bezogen auf die Katode - mehr und mehr positiv wird, fließt zunächst ein nur geringer Strom. Erst nach Überschreiten eines gewissen Spannungswertes U_d steigt die Stromstärke steil an. Dabei nimmt der Spannungsabfall über der Diode kaum zu. Den Wert U_d bezeichnet man als Durchlaß-, Fluß- oder Kniespannung der Diode. Bei geringen Spannungen und Strömen entspricht die Kennlinie in guter Näherung einer Exponentialfunktion.

Die Sperrrichtung

Wenn, von Wert 0 an beginnend, die Spannung an der Anode - bezogen auf die Katode - mehr und mehr negativ wird, fließt zunächst ein nur geringer Strom, der *Sperrstrom*. Erst nach Überschreiten eines gewissen Spannungswertes $-U_{\text{sperr}}$ steigt die Stromstärke steil an. Dabei nimmt der Spannungsabfall über der Diode kaum zu. Den Wert U_{sperr} bezeichnet man als maximale Sperrspannung, als Durchbruchspannung oder als Zenerspannung. Bei "gewöhnlichen" Dioden darf dieser Spannungswert im praktischen Betrieb nie erreicht werden. Nur bei den sog. Zenerdioden werden die Durchbrucheffekte praktisch ausgenutzt.

Wir merken uns:

1. Der Stromfluß beginnt bereits bei geringen Spannungen in Flußrichtung. Ein geringer Strom bewirkt auch nur einen geringen Spannungsabfall (exponentielle Abhängigkeit).
2. Über einer Diode, die in Flußrichtung von einem hinreichend starken Strom durchflossen wird, fällt eine Spannung ab, die der Flußspannung entspricht. Der Spannungsabfall nimmt mit wachsender Stärke des Durchlaßstroms nur geringfügig zu (mit anderen Worten: die Diode ist extrem niederohmig, also näherungsweise ein geschlossener Schalter).
3. Durch eine Diode in Sperrrichtung fließt nur ein sehr geringer Sperrstrom, der praktisch nicht nennenswert von der anliegenden Sperrspannung abhängt (mit anderen Worten: die Diode ist extrem hochohmig, also näherungsweise ein offener Schalter).
4. Die im Betrieb anliegende Sperrspannung muß stets geringer sein als die maximale Sperrspannung (Durchbruch- oder Zenerspannung).

Der Übergang in den Bereich des steilen Anstiegs wird durch eine Spannungsangabe gekennzeichnet:

- Schwellenspannung (Threshold Voltage V_{Th}) oder Schleusenspannung U_s : an den steil ansteigenden Bereich der Kennlinie wird eine Tangente angelegt und bis zur Spannungsachse verlängert,
- Flußspannung U_d (Forward Voltage V_F): dies ist typischerweise die über der Diode abfallende Spannung, wenn 1/10 des Nennstroms hindurchfließt.

Wie hoch ist die Flußspannung?

Das hängt vom Halbleiter-Basismaterial und von der Ausführung der Diode ab. Anhaltswerte:

- Siliziumdioden: 0,5...0,8 V (typisch 0,7 V),
- Germaniumdioden: 0,2...0,4 V (typisch 0,35 V),
- Schottky-Dioden: 0,35...0,5 V (typisch 0,45 V).

Abbildung 2.1.3 veranschaulicht die Unterschiede anhand von Kennlinien einer Silizium- und einer Germaniumdiode, die in einem gemeinsamen Koordinatenkreuz dargestellt sind.

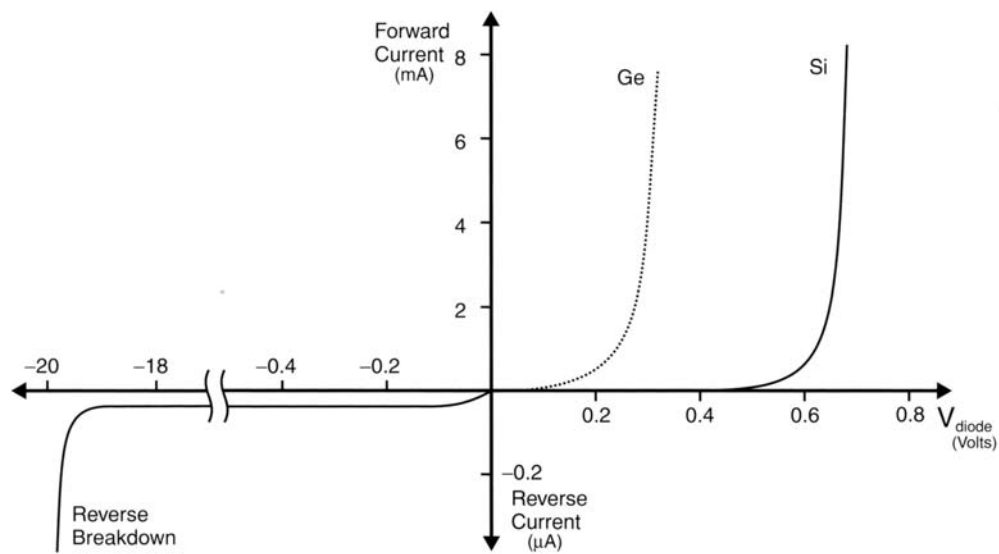


Abbildung 2.1.6 Kennlinien einer Germanium- und einer Siliziumdiode

In vielen Einsatzfällen ist der typische Wert der Flußspannung eine sinnfällige Größe, um sich die Wirkungsweise von Schaltungen klarzumachen oder um in der Hardware zu messen. Genaugenommen hat die Kennlinie aber in der "Gegend", wo der Durchlaßstrom zu fließen beginnt, keinen plötzlichen Knick. Sie ist vielmehr in charakteristischer Weise gekrümmt. Hierbei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Typen. Und genau dieser Verlauf ist bei manchen Anwendungen (z.B. als Leistungsgleichrichter) von besonderer Bedeutung. Deshalb wird in den Datenblättern gelegentlich der genaue Kennlinienverlauf in der "Umgebung" des Flußspannungs-Wertes graphisch dargestellt (Abbildung 2.1.4).

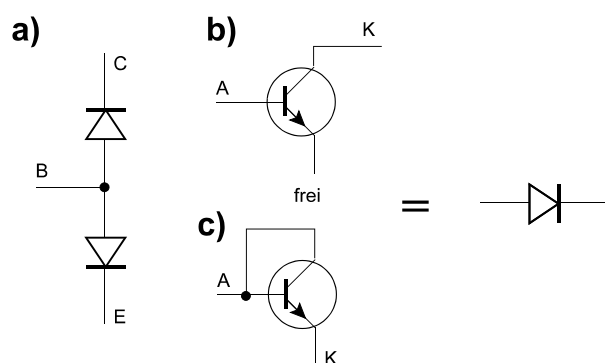


Abbildung 2.1.7 Die Basis-Kollektor-Strecken eines Transistors können als Diode genutzt werden. a) der NPN-Transistor als Verbund zweier Dioden (Ersatzschaltung). b) die Diode zwischen Basis und Kollektor hat geringe Leckströme, aber längere Schaltzeiten. c) die Diode zwischen Basis und Emitter hat besonders kurze Schaltzeiten. Die zulässige Sperrspannung ist aber gering (Richtwert: 5...6 V).

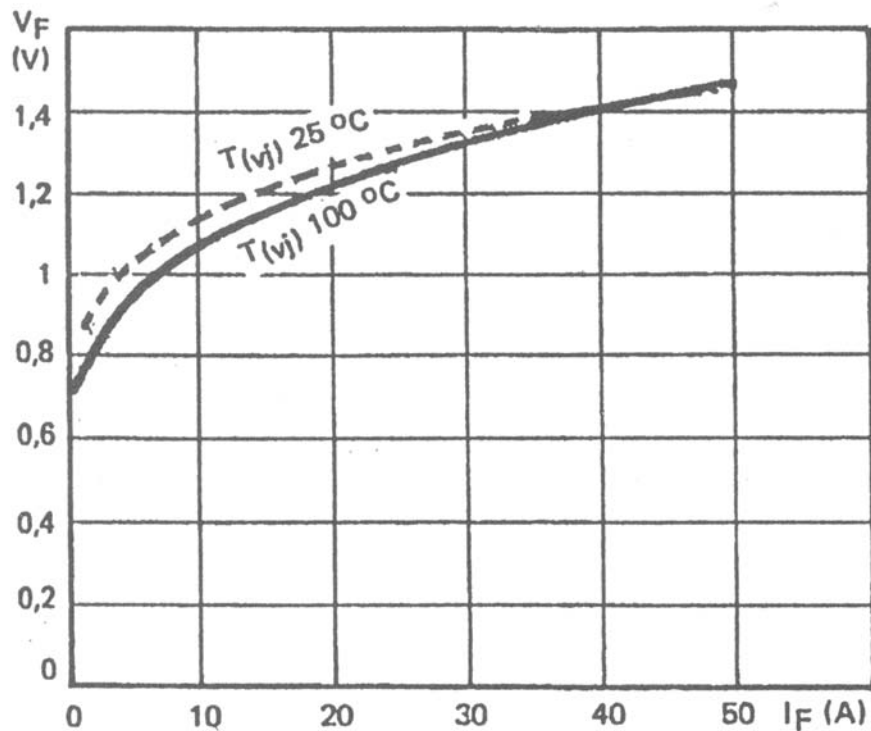


Abbildung 2.1.8 Spannungsabfall V_F in Flußrichtung als Funktion des Durchlaßstromes I_F (Gleichrichterdiode BY 233; Quelle: SGS-Thomson)

Hinweis:

Man hat hier die Graphik gegenüber der lehrbuchmäßigen Darstellung (Abbildungen 2.1.2, 2.1.3) umgedreht, um die Abhängigkeit des Spannungsabfalls vom Strom deutlich herauszustellen (bei Gleichrichteranwendungen ist der Stromfluß gegeben, und man will wissen, mit welchem Spannungsabfall bei einer bestimmten Stromstärke zu rechnen ist).

2.1.1.2 Zur Anwendungspraxis

Diodenanwendungen in Embedded Systems

Dioden werden sowohl innerhalb integrierter Schaltungen als auch - in beträchtlichen Stückzahlen - als Einzelbauelemente eingesetzt (Abbildung 2.1.5). In Embedded Systems haben folgende Anwendungsgebiete die größte Bedeutung:

- Gleichrichten von Wechselspannungen,
- Spannungsstabilisierung,
- Begrenzungs- und Schutzfunktionen,
- Ventil- und Schaltfunktionen,
- optische Wirkungen (Licht aussenden (Leuchtdioden), Licht empfangen (Photodioden)).

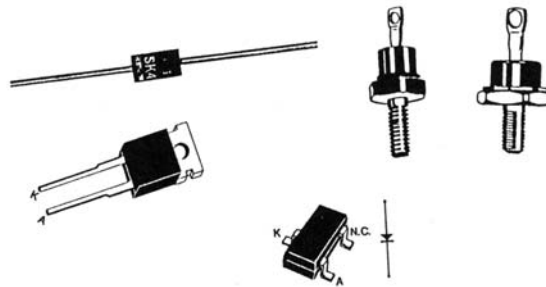


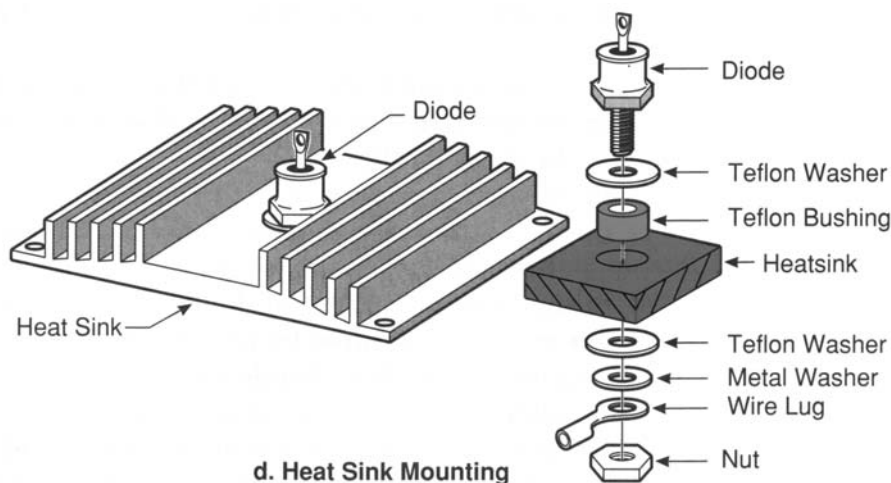
Abbildung 2.1.9 Dioden

Anschlußkennzeichnung

Dioden in zylindrischen Bauformen haben einen Ring am Gehäuse, der die Katode kennzeichnet. Bei manchen Dioden in Plastikgehäusen (mit beiden Anschlüssen nebeneinander) sind die Anschlußdrähte unterschiedlich lang. Der kürzere ist die Katode. Ist die Anschlußbelegung nicht eindeutig erkennbar, hilft nur Messen.

Dioden für Kühlkörpermontage

Sind beide Anschlüsse gegenüber den Montage-Vorkehrungen (Schraubgewinde, Platte mit Befestigungsbohrung o. ä.) völlig isoliert, ist nichts zu beachten. Ansonsten: es gibt "katodenverbundene" und "anodenverbundene" Typen (der montierte Kühlkörper ist dann - wenn nicht durch Zwischenlagen, Montage mit Kunststoffschrauben usw. isoliert - entweder mit der Katode oder der Anode verbunden). Meistens hat die "Vorzugsausführung" die Katode am Gehäuse. Praktisch alle einschlägigen Typen werden aber auch mit der Anode am Gehäuse geliefert. Achten Sie also auf die genauen Typen- und Bestellnummern! (So sind zum Aufbau von Brückengleichrichtern je zwei Dioden in jeder Bauform zweckmäßig.)



Mehrfachdioden

Mehrfachdioden-Bauelemente enthalten mehrere unabhängige Dioden oder Diodenkombinationen, die für bestimmte Anwendungen gleichsam vorgefertigt sind (als Schutzdioden-Anordnungen, als Zweiweg- oder Brückengleichrichter usw.).

Dioden im Schaltplan

In Abbildung 2.1.6 sind die üblichen Schaltsymbole für Dioden zusammengestellt. Beachten Sie die bildhafte Symbolik: der Querstrich ist die Katode, und der Pfeil zeigt in Flußrichtung, wenn die Anode an positiverer Spannung liegt (technische Stromrichtung von Plus nach Minus).

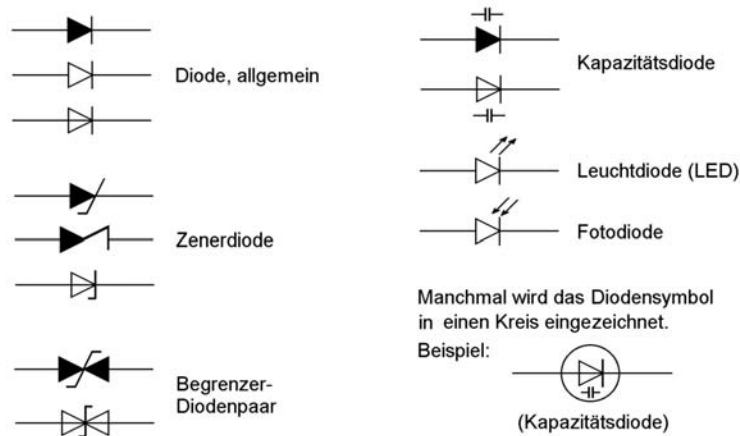


Abbildung 2.1.10 Schaltsymbole für Dioden

2.1.2 Siliziumdioden

2.1.2.1 Statische Kennwerte

Das Strom-Spannungs-Verhalten der "gewöhnlichen" Siliziumdiode ist aus den Abbildungen 2.1.2 und 2.1.3 ersichtlich. Im folgenden geben wir zunächst einen Überblick über die Kennwerte, die wir bisher besprochen haben und nennen die in Datenblättern üblichen Bezeichnungen.

Maximaler Durchlaßstrom (Forward Current I_F)

Zu Schalt- und Kleinleistungsdioden findet man oft nur eine einzige Durchlaßstromangabe. Leistungsgleichrichter werden hingegen durch mehrere Werte charakterisiert. Wir nennen hier die wichtigsten:

- Dauergrenzstrom (Average Forward Current I_{FAV}): der höchste zulässige Mittelwert eines sinusförmigen Durchlaßstromes im Dauerbetrieb (bezogen auf einen Frequenzbereich von 50...60 Hz).
- Dauergleichstrom (I_{FDC}): der höchste Gleichstrom, der in Durchlaßrichtung fließen darf. Faustregel: $I_{FDC} = 1,5 I_{FAV}$.
- höchster periodischer Durchlaßstrom (Repetitive Peak Forward Current I_{FRM}): der höchste zulässige Augenblickswert des Durchlaßstromes, der periodisch wiederholt auftreten darf (die Höchstdauer der Erregung steht im Datenblatt; typisch sind $\approx 10 \mu s$).
- Stoßstromgrenzwert (Surge Non Repetitive Forward Current I_{FSM}): der höchste zulässige Augenblickswert des Durchlaßstromes, der bei nicht periodischem Auftreten zulässig ist (wie der Bezugs-Stromstoß aussieht, steht im Datenblatt; typisch ist eine Sinus-Halbwelle von 10 ms Dauer).

Flußspannung (Forward Voltage V_F)

Die Flußspannung (Pauschalwert für SI-Dioden um 0,7 V) ist - genau genommen - stromabhängig^{*}). Die Datenblätter nennen deshalb meist nur 1 oder 2 Werte im Tabellenteil^{*)} und geben genauere Abhängigkeiten graphisch an (vgl. Abbildung 2.1.4). "Dicke" Leistungsgleichrichter für Ströme von 100 A und mehr haben Flußspannungen um 1,5... > 2 V.

^{*}): exponentielles Wachstum. Richtwert: bei geringen Strömen um 60...120 mV/Dekade (Verzehnfachung der Stromstärke).

^{**}): ein typischer Datenblattwert: Spannungsabfall bei 10% des maximalen Durchlaßstroms.

Temperaturgang der Flußspannung bei konstantem Durchlaßstrom: etwa - 2 mV/K (Richtwert). Liegt eine konstante Spannung an, so steigt der Durchlaßstrom exponentiell mit der Temperatur.

Sperrstrom (Reverse Current I_R)

Der Sperrstrom von Siliziumdioden ist sehr gering und hängt im wesentlichen von der Betriebstemperatur ab (Bereich von wenigen nA bis zu einigen μ A bei stark belasteten Leistungsgleichrichtern; beispielsweise 50 μ A Sperrstrom und 80 A Durchlaßstrom). Genauere Abhängigkeiten werden üblicherweise graphisch dargestellt.

Temperaturgang des Sperrstroms: Verdoppelung bei 10K Temperaturerhöhung ($2^{\frac{\Delta t}{10}}$).

Maximale Sperrspannung (Peak Reverse Voltage V_R)

Bei Schalt- und Kleinleistungsdioden reicht meist ein einziger Wert für die Sperrspannung. Bei Leistungsgleichrichtern sind hingegen - gemäß den verschiedenen Betriebsfällen - mehrere Sperrspannungsangaben erforderlich.

- höchste periodische Spitzensperrspannung (Repetitive Peak Reverse Voltage V_{RRM}): der höchste Augenblickswert der Sperrspannung, der periodisch wiederholt auftreten darf.
- höchste Stoßspitzensperrspannung (Non Repetitive Peak Reverse Voltage V_{RSM}): der höchste Augenblickswert der Sperrspannung, der bei nicht periodischem Auftreten zulässig ist (maximale Dauer: 10 ms).
- empfohlene Anschlußspannung (V_{RMS}): Nenn-Effektivwert der anliegenden sinusförmigen Wechselspannung (bei Gleichrichter-Anwendungen).
- Faustregel: $V_{RMS} = 0,5 V_{RRM}$.

Verlustleistung (Power Dissipation P_{tot})

Die Verlustleistung ergibt sich - näherungsweise gerechnet - als Produkt von Durchlaßstrom und Flußspannung: $P_{tot} = I_{FAV} \cdot V_F$. Angaben zu Gehäusetemperatur und Anforderungen an die Kühlung beachten!

2.1.2.2 Das dynamische Verhalten

Wenn eine Diode umgepolt wird, laufen Vorgänge ab, die Zeit erfordern. Betrachten wir dazu nochmals die einfachen Skizzen zum PN-Übergang in Abbildung 2.1.1. Nehmen wir an, die

Diode werde in Sperrichtung betrieben. Dann ist der eigentliche PN-Übergang (die Sperrschicht) nahezu frei von Ladungsträgern. Nun polen wir die Spannung um. Jetzt muß die Diode leiten. Aber dazu müssen erst einmal die Ladungsträger zur Sperrschicht kommen. Diesen Effekt bezeichnet man als *Durchlaßfähigkeit*, und der entsprechende Zeit-Kennwert heißt Durchlaßverzögerungszeit (Forward Recovery Time t_{fr}). Bei Schalter-Anwendungen kann es sein, daß man mit dieser Verzögerung rechnen muß; bei Gleichrichter-Anwendungen ist sie weniger von Bedeutung. Schließlich geschieht nicht mehr, als daß die Sperrwirkung erst einige ns nach dem Umpolen aufgehoben wird.

Was passiert aber im umgekehrten Fall? - Die Diode leitet, folglich ist die Sperrschicht mit Ladungsträgern regelrecht überflutet. Nun wird auf "Sperrern" umgepol. Zunächst sind aber noch Ladungsträger in der Sperrschicht. - Die Folge: eine gewisse Zeit kann ein recht starker Strom (theoretisch: in Höhe des Durchlaßstromes) in Sperrichtung fließen! Erst dann, wenn sich die Ladungsträger aus der Sperrschicht "zurückgezogen haben" (man spricht hier bildhaft vom "Ausräumen"), ist die Diode wirklich gesperrt. Diesen Effekt bezeichnet man als *Sperrfähigkeit*; der Zeit-Kennwert heißt Sperrverzögerungszeit (Backward Recovery Time t_{rr}). Abbildung 2.1.7 veranschaulicht das beschriebene Verhalten.

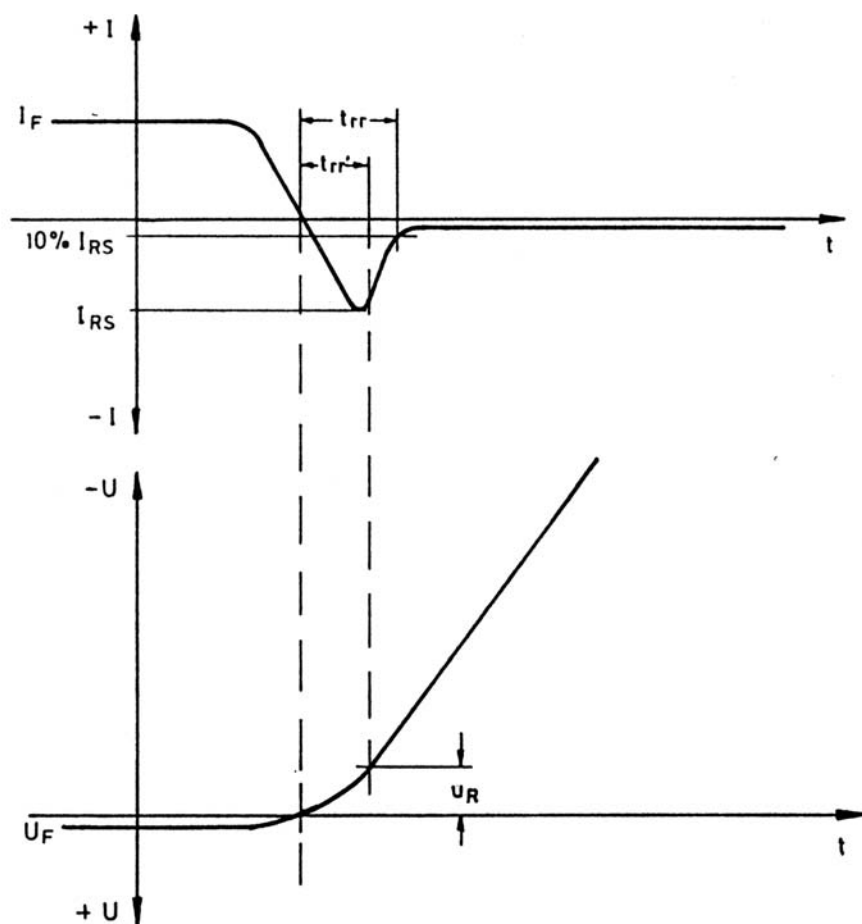


Abbildung 2.1.11 Das Verhalten der Diode beim Umschalten. Oben: der Stromfluß durch die Diode (Durchlaßstrom I_F - Ausräumstrom I_{RS} - Sperrstrom), unten: die Spannung über der Diode (Flußspannung - Sperrspannung)

Es ist offensichtlich, daß die halbe Periodendauer einer gleichzurichtenden Wechselspannung viel länger sein sollte als die Sperrträchtigkeit. Sind Wechselspannungen höherer Frequenz gleichzurichten (Spannungswandler, Schaltnetzteile), braucht man Dioden mit besonders geringer Sperrverzögerungszeit (Fast Recovery Diodes). Man erreicht dies durch besondere Gestaltung der Sperrschicht. (So liegt es nahe, die Sperrschicht vergleichsweise hochohmig auszulegen, so daß weniger Ladungsträger auszuräumen sind.)

Orientierungswerte:

Bei modernen Leistungsgleichrichtern liegt t_{fr} um 10 ns und t_{rr} um 200...50 ns.

Abbildung 2.1.8 zeigt die Verbesserung, die sich ergibt, wenn weniger Ladungsträger auszuräumen sind.

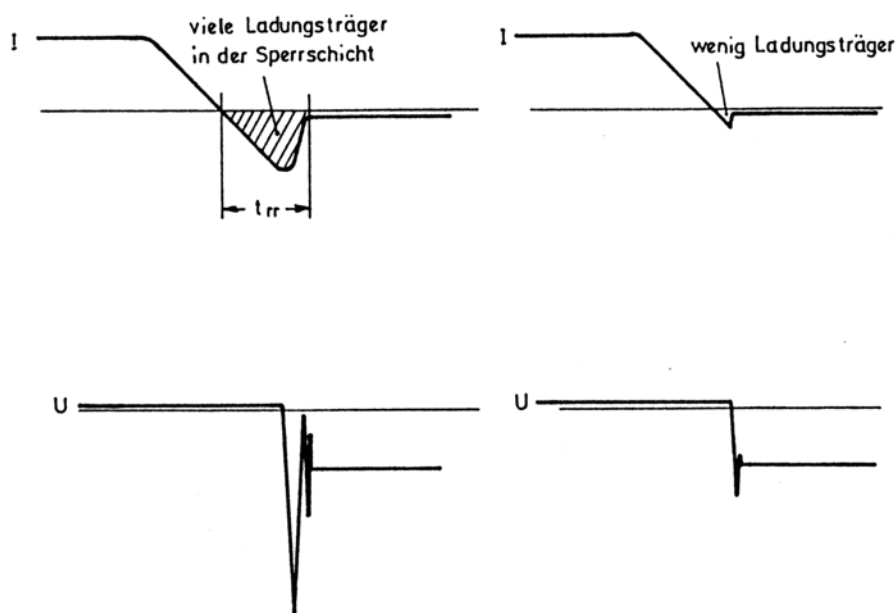


Abbildung 2.1.12 Die Sperrträchtigkeit bei verschiedenen Auslegungen der Sperrschicht

Es ist aber auch erkennbar, was es bedeutet, wenn die Sperrschicht sehr schnell ausgeräumt wird: der Ausräum-Strom bricht schlagartig zusammen. Und das hat zur Folge, daß kräftige Spannungsspitzen induziert werden, die auf jeden Fall Störungen hervorrufen, wenn nicht gar den Totalausfall der Diode. Der Ausweg: Man muß nicht nur die Ausräumzeit verkürzen (Fast Recovery), sondern auch dafür sorgen, daß das Ausräumen "sanft" abläuft (Soft Recovery; Abbildung 2.1.9).

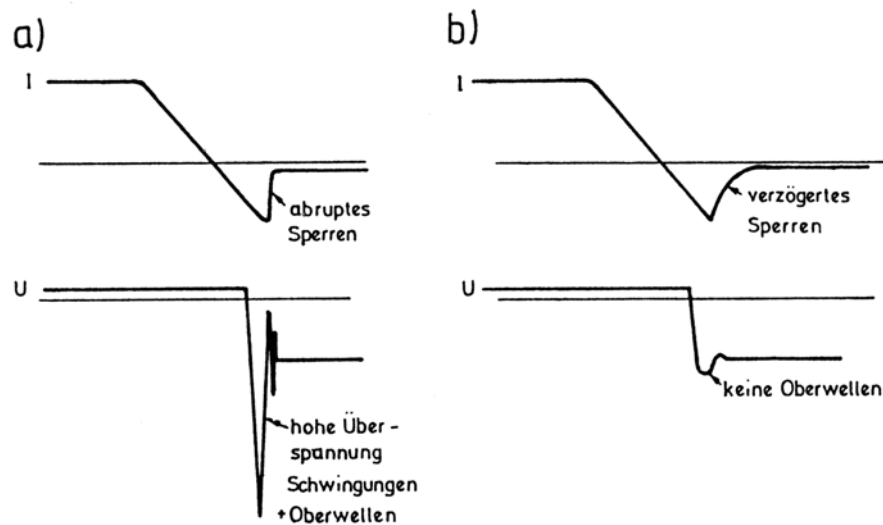


Abbildung 2.1.13 Der Verlauf des Ausräumstroms. (a) steiler, b) verzögerter Abfall (Soft Recovery)

2.1.3 Schottky-Dioden

Schottky-Dioden beruhen auf einem Metall-Halbleiter-Übergang. Sie haben gegenüber "gewöhnlichen" Siliziumdioden folgende Besonderheiten:

- die Flußspannung ist etwa auf die Hälfte reduziert (typisch 0,35...0,45 V),
- die Sperrschichtkapazität ist deutlich geringer (wenige pF) und kaum spannungsabhängig,
- der Ausräumstrom ist praktisch vernachlässigbar,
- die Durchlaß- und Sperrverzögerungszeiten sind sehr gering (man gibt meist nur einen Wert als "Schaltzeit" τ an; Größenordnung: 100 ps). Achtung: es können geringe Restströme noch einige Zeit fließen (z. B. einige μA für etwa $1\mu\text{s}$). Die Ursache: ein parasitärer pn-Übergang, der dem eigentlichen Schottky-Übergang parallel liegt.

Abbildung 2.1.10 veranschaulicht diese Unterschiede anhand von Kennlinien und Werteverläufen (1N1418 ist eine "Wald-und-Wiesen"-Siliziumdiode, die BAR- und BAT-Typen sind Schottky-Dioden).

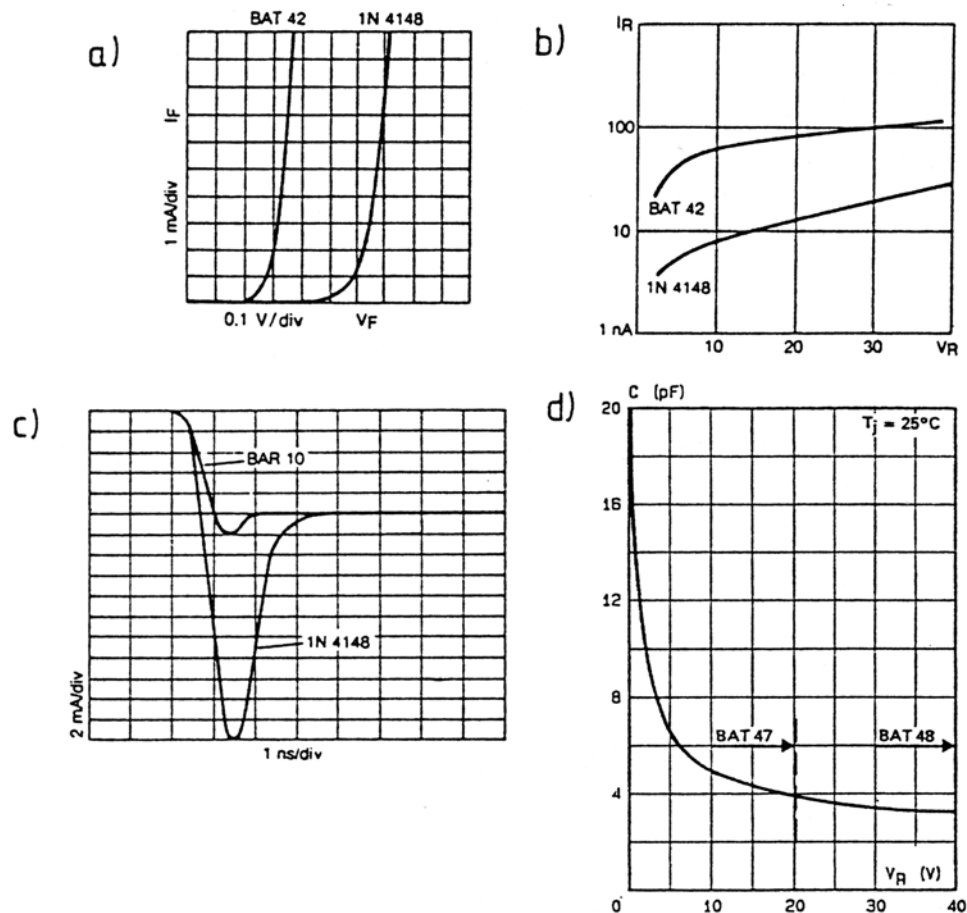


Abbildung 2.1.14 Das statische und dynamische Verhalten von Schottky-Dioden. a) statische Kennlinie in Durchlaßrichtung, b) statische Kennlinie in Sperrrichtung, c) Verlauf des Ausräumstromes, d) Sperrschichtkapazität in Abhängigkeit von der Sperrspannung (Quelle: SGS-Thomson).

2.1.4 Kapazitätsdioden

Eine in Sperrrichtung betriebene Diode ist praktisch ein Kondensator, dessen Dielektrikum die Sperrschicht ist. Weshalb? - Zwischen Katode und Anode liegt eine Spannung, es fließt aber (fast) kein Strom: die Sperrschicht wirkt als Isolator. Die tatsächliche Dicke der Sperrschicht hängt von der anliegenden Sperrspannung ab. Je höher die Spannung, um so dicker die Sperrschicht bzw. das Dielektrikum (Abbildung 2.1.11). Das heißt, die Sperrschichtkapazität kann durch die Sperrspannung verändert werden. Kapazitätsdioden (Abstimmioden, Varicaps, Varaktoren) sind ausdrücklich für diese Nutzungsweise entwickelt worden. Abbildung 2.1.12 zeigt die Sperrschichtkapazität als Funktion der Sperrspannung für verschiedene Diodentypen (daraus geht auch die typische Größenordnung der Sperrschichtkapazität hervor).

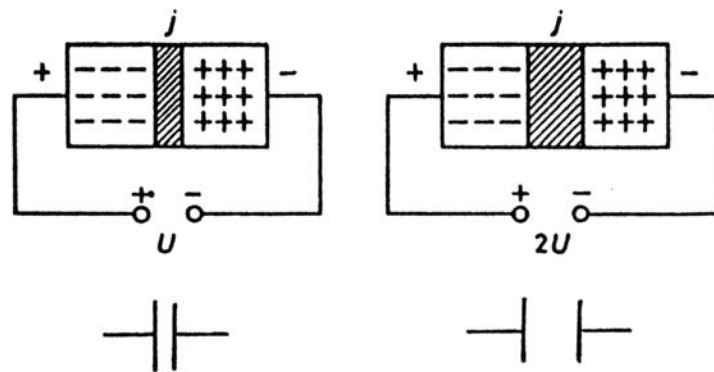


Abbildung 2.1.15 Die Sperrschichtkapazität - das Prinzip der Kapazitätsdiode

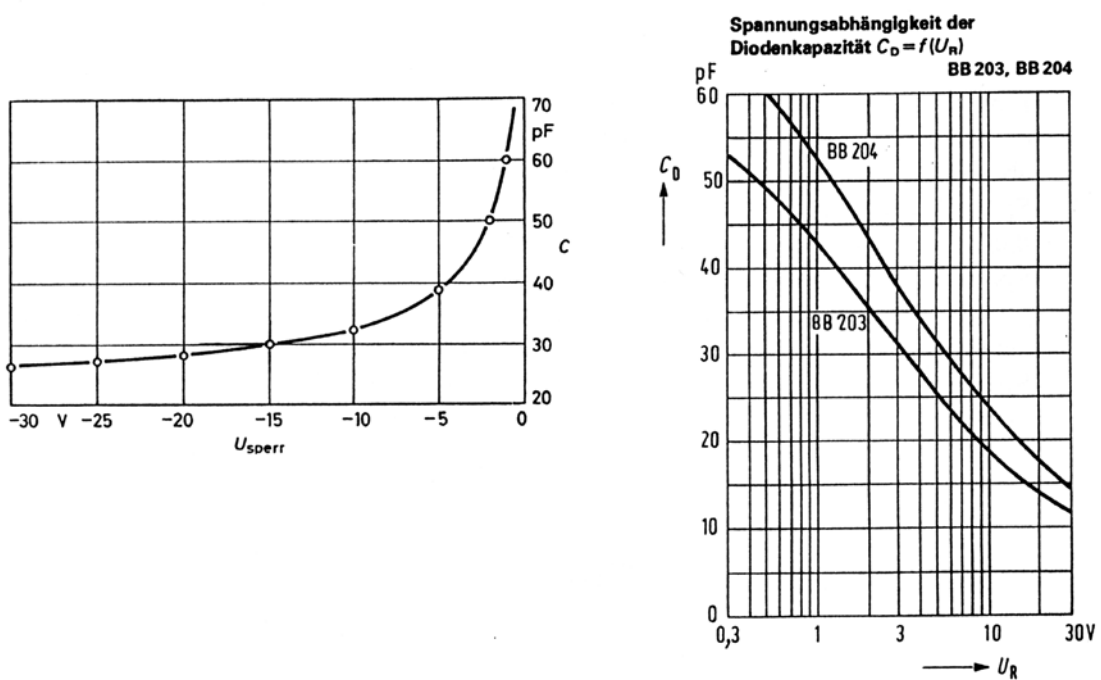


Abbildung 2.1.16 Die Sperrschichtkapazität in Abhängigkeit von der Sperrspannung. Links: linearer, rechts: logarithmischer Maßstab (Quellen: AEG-Telefunken, Siemens)

Abbildung 2.1.13 zeigt, wie man eine Kapazitätsdiode einsetzen kann, um einen Schwingkreis abzustimmen.

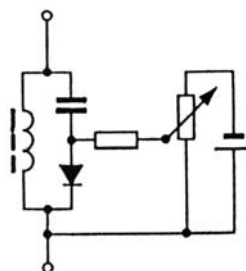


Abbildung 2.1.17 Schwingkreis-Abstimmung mittels Kapazitätsdiode

2.1.5 Zenerdioden

Zenerdioden werden in Sperrichtung betrieben, und zwar im Bereich ihrer Durchbruchspannung. Sie dienen zur Spannungsstabilisierung oder zu Schutzzwecken. Die Zenerspannungen liegen im Bereich von 2 bis 200 V, wobei die Nennwerte gemäß E-Reihe gestaffelt sind. Tabelle 2.1.1 gibt einen Überblick über eine typische Zenerdioden-Baureihe. Bei üblichen Siliziumdioden liegt die Durchbruchspannung in einer Größenordnung von 100 V und mehr, und man ist bestrebt, diese so hoch wie möglich zu halten. Zenerdioden sind hingegen für praktisch brauchbare Durchbruchspannungen (Zenerspannungen) entwickelt worden. (Die Zenerspannung ist *der* Kennwert einer Zenerdiode.) Z-Dioden gibt es mit Zenerspannungen zwischen 2,5 und 200 V. Abbildung 2.1.14 zeigt die Sperr- und Durchlaßkennlinien typischer Zenerdioden.

Je höher die Sperrspannung, um so mehr werden die Ladungsträger aus dem Bereich des PN-Übergangs förmlich zu dann Anschlüssen hin abgesaugt, so daß eigentlich nichts weiter passieren dürfte (vgl. Abbildung 2.1.11). Hohe Sperrspannung bedeutet aber auch hohe Feldstärke. Von einem gewissen Spannungswert an wird die Feldstärke so hoch, daß Elektronen aus ihren Bindungen im Halbleitermaterial gerissen werden und somit als freie Ladungsträger zur Verfügung stehen. Die Folge: der Widerstand sinkt beträchtlich, und der Sperrstrom nimmt schlagartig zu (Durchbruch). „Zenerdiode“ (Z-Diode) ist die Allgemeinbezeichnung. Tatsächlich werden zwei Durchbruchseffekte ausgenutzt:

- der eigentliche Zener-Effekt. Tritt in dünnen, hochdotierten Sperrschichten bei vergleichsweise geringen Sperrspannungen (ca. 5...6 V) auf. Temperaturkoeffizient negativ.
- der Avalanche-Effekt (Lawinendurchbruch). Tritt in dickeren Sperrschichten bei höheren Sperrspannungen (ab etwa 6 V) auf. Temperaturkoeffizient positiv.

Temperaturkoeffizient: etwa $\pm 0,1...0,001$ V/K.

Der Zener-Effekt ist „schlechter“ als der Avalanche-Effekt (Durchbruchskennlinie nicht so steil, schlechterer TK).

Im Bereich um 5 V (4...7 V) werden beide Effekte wirksam. Somit heben sich die Temperaturgänge weitgehend auf; es ergibt sich ein sehr geringer Temperaturkoeffizient. Anwendung: Referenzspannungsquellen. (Bauelemente mit eingebauter Temperaturkonstanzhaltung: 0,5...1 ppm/K; Langzeitstabilität 5...10 ppm/K über 1000 h.) Vertragen aber nur geringe Ströme (Richtwert: ca. 10 mA).

Z-Diode halten keine übermäßige Strombelastung über längere Zeit aus. Derating-Kurven beachten!

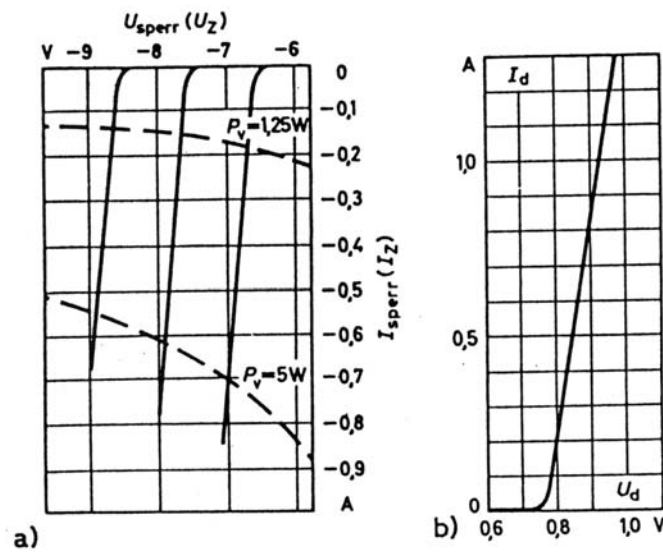


Abbildung 2.1.18 a) Sperr- und b) Durchlaßkennlinien typischer Zenerdioden

Types	V_{ZT}/I_{ZT}^*		r_{ZT}/I_{ZT} max (Ω)	I_{ZT} (mA)
	min (V)	max		
P ZPY3V9	3.7	4.1	7	100
P ZPY4V3	4.0	4.6	7	100
P ZPY4V7	4.4	5.0	7	100
P ZPY5V1	4.8	5.4	5	100
P ZPY5V6	5.2	6.0	2	100
P ZPY6V2	5.8	6.6	2	100
ZPY6V8	6.4	7.2	2	100
P ZPY7V5	7.0	7.9	2	100
P ZPY8V2	7.7	8.7	2	100
P ZPY9V1	8.5	9.6	4	50
P ZPY10	9.4	10.6	4	50
ZPY11	10.4	11.6	7	50
P ZPY12	11.4	12.7	7	50
ZPY13	12.4	14.1	9	50
P ZPY15	13.8	15.8	9	50
ZPY16	15.3	17.1	10	25
ZPY18	16.8	19.1	11	25
ZPY20	18.8	21.2	12	25
P ZPY22	20.8	23.3	13	25
P ZPY24	22.8	25.6	14	25
P ZPY27	25.1	28.9	15	25
ZPY30	28	32	20	25
P ZPY33	31	35	20	25
P ZPY36	34	38	60	10
ZPY39	37	41	60	10
ZPY43	40	46	80	10
ZPY47	44	50	80	10
ZPY51	48	54	100	10
ZPY56	52	60	100	10
ZPY62	58	66	130	10
ZPY68	64	72	130	10
ZPY75	70	79	160	10
ZPY82	77	88	160	10
ZPY91	85	96	250	5
ZPY100	94	106	250	5

* Pulse test : $20ms \leq t_p \leq 50ms$ $\delta < 2\%$.
 The regulation voltages are defined according to the E24 series.
 P : Preferred Voltage

Tabelle 2.1.1 Eine typische Zenerdioden-Baureihe (Auszug aus dem Datenblatt; Quelle: SGS-Thomson)

Diodenschaltungen

Die Diode als Gleichrichter

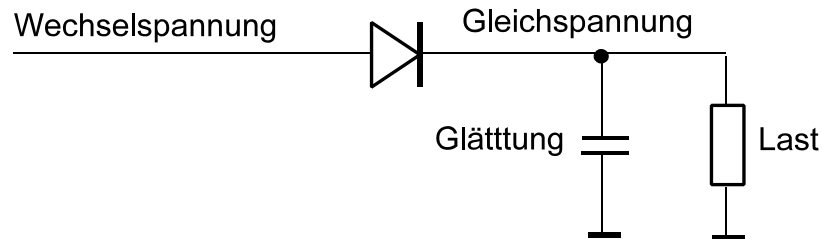


Abbildung 3.1.19 Der grundsätzliche Versuchsaufbau

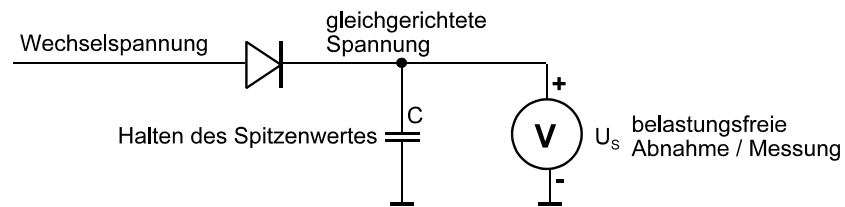


Abbildung 3.1.20 Spitzenwertgleichrichter

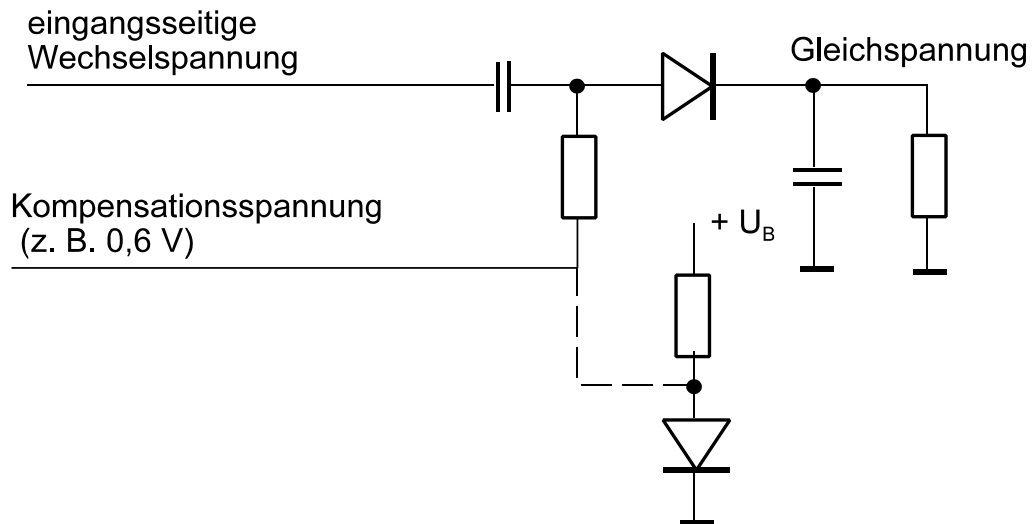


Abbildung 3.1.21 Kompensation der Flußspannung. Die Kompensationsspannung kann u. a. mit einer zweiten Diode erzeugt werden.

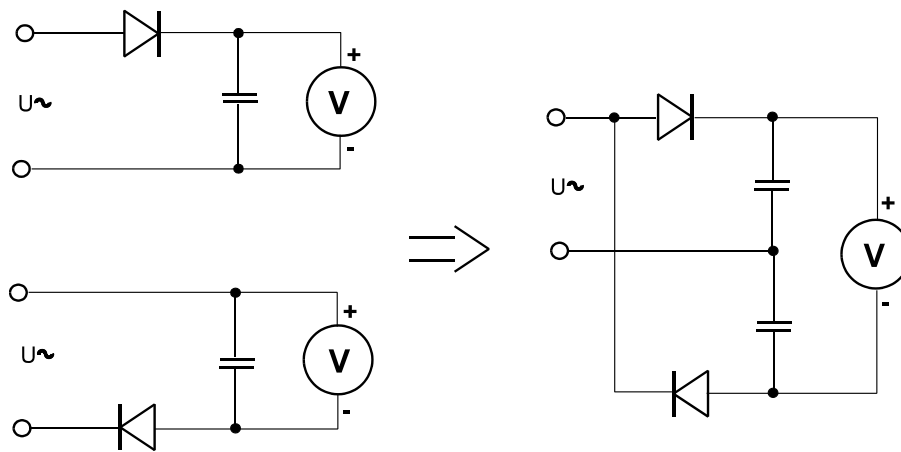


Abbildung 3.1.22 Spannungsverdoppler (1). Delon- oder Greinacherschaltung

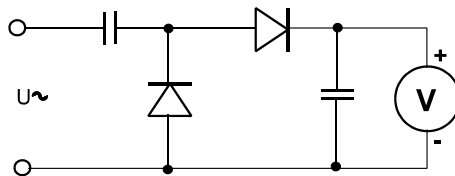


Abbildung 3.1.23 Spannungsverdoppler (2). Villardschaltung

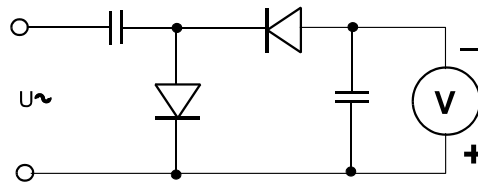


Abbildung 3.1.24 Durch Umpolen der Dioden hat die Ausgangsspannung umgekehrte Polarität.

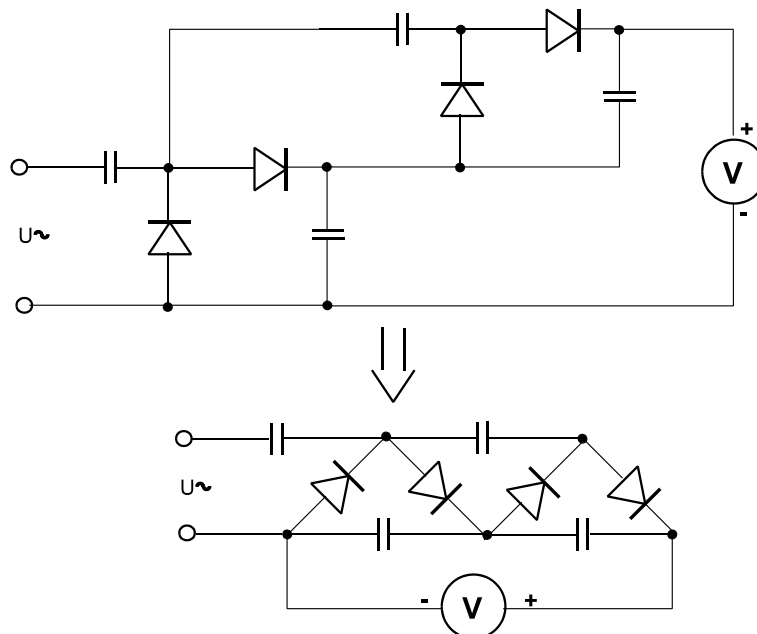


Abbildung 3.1.25 Spannungsvervielfachung mit mehreren (hier zwei) Villardstufen (Vervierfachung)

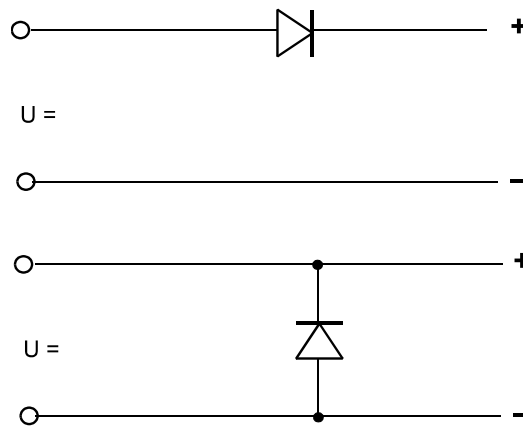


Abbildung 3.1.26 Verpolschutz

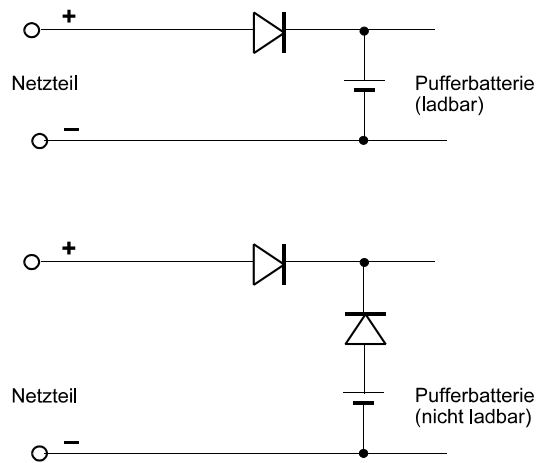


Abbildung 3.1.27 Sperrdioden (Rückstromsperre)

Spannungsstabilisierung

Abbildung 2.1.15 zeigt die einfachste Stabilisierungsschaltung. Wir verwenden diese einfache Schaltung als erstes Lehrbeispiel der Schaltungsberechnung.

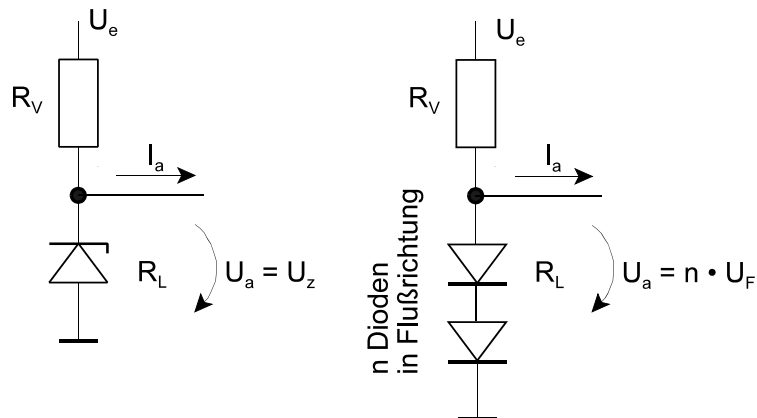


Abbildung 3.1.28 Spannungsstabilisierung. a) mit Zenerdiode (Sperrichtung); b) mit Diode(n) in Flußrichtung.

• **Klammerschaltungen, Torschaltungen, Begrenzer**

- Klammerschaltungen (Abb. 3.1) sollen Signale auf einen bestimmten Bezugspegel beziehen.
- Torschaltungen (Abb. 3.2) sollen Signalflüsse steuern (mit anderen Worten, Signale durchlassen oder nicht durchlassen).
- Begrenzer (Abb. 3.3 und 3.4) sollen verhindern, daß bestimmte Pegel überschritten werden.

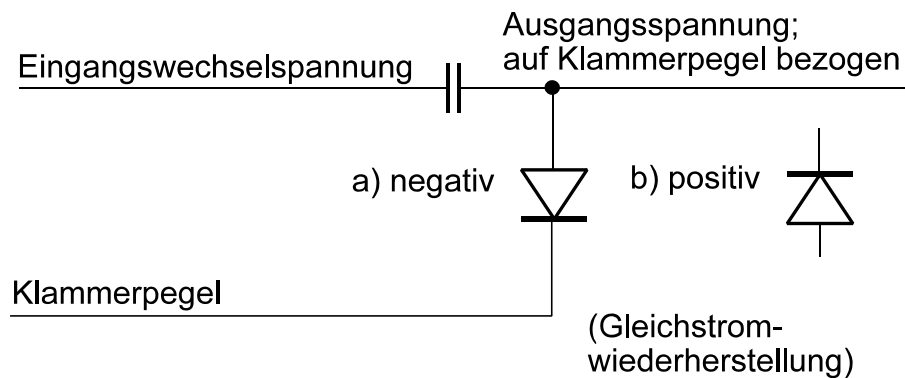


Abbildung 4.1.1 Klammerschaltung. Die Ausgangsschweblspannung erscheint auf den Klammerpegel bezogen. Der Klammerpegel kann auch Masse sein (Gleichstromwiederherstellung)

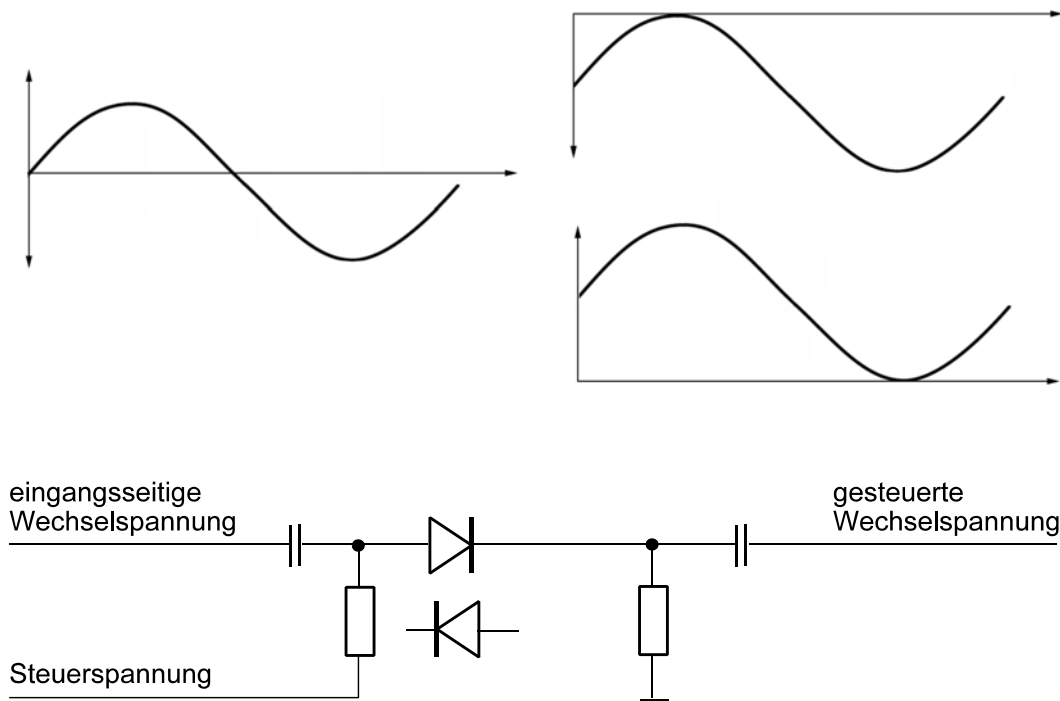


Abbildung 4.1.2 Torschaltung. Ist Steuerspannung + maximaler Wechselspannungswert < Sperrspannung, so ist der Signalweg gesperrt

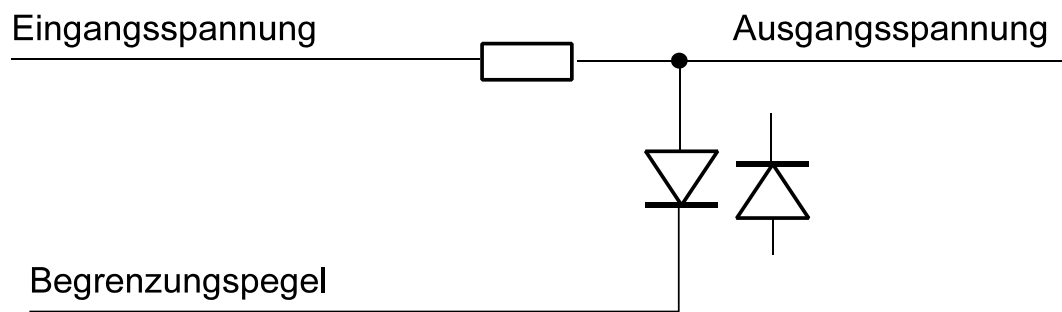


Abbildung 4.1.3 Begrenzer. Übersteigt die Eingangsspannung den Begrenzungspegel, so wird die Diode in Flußrichtung gepolt und somit leitend. Ausgangsspannung deshalb maximal = Begrenzungsspannung + Flußspannung. Der Widerstand dient der Strombegrenzung

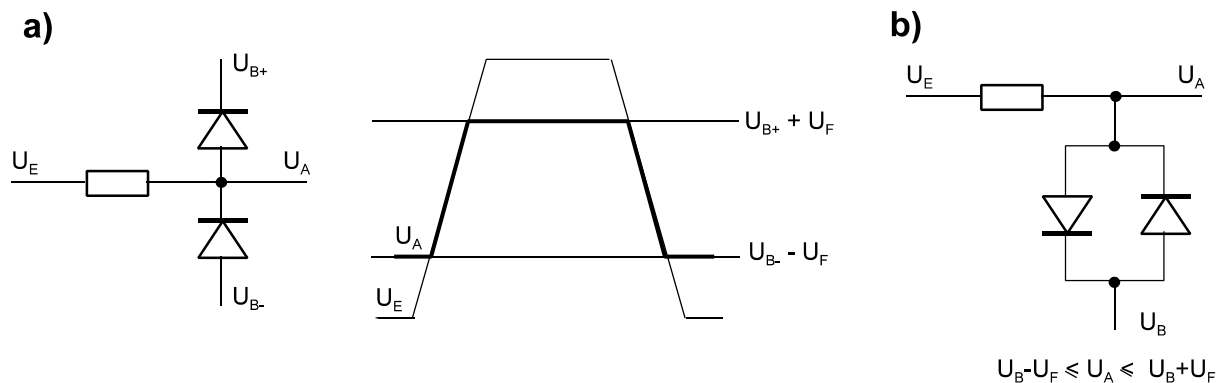


Abbildung 4.1.4 Schutzbeschaltungen mit Begrenzerdioden. a) Begrenzung des Signalhubes auf einen bestimmten Spannungsbereich, b) Begrenzung auf einene Bereich, dessen Breite der doppelten Flußspannung entspricht

Hinweis:

Begrenzung bedeutet stets eine Art Kurzschließen bzw. Ableiten der überschüssigen Signalamplitude. Zu beachten:

- die Strombelastung der Signalquelle,
- die Belastbarkeit der Dioden,
- ggf. Probleme, die mit dem Ableiten der eingespeisten Ströme zu tun haben (Anhebung des Massepotentials, Störstrahlung).

Strombegrenzung durch Serienwiderstand (wie in den Abb. 3.3 und 3.4 gezeigt) ist nicht immer möglich (Flankenverschleifung). Viele Begrenzerschaltungen sind nur geeignet, kurzzeitige Spitzen (z. B. Überschwinger) abzuleiten. Liegt die Überspannung länger an, sind andere Maßnahmen erforderlich (z. B. Auftrennen des Stromkreises).

4. Diodengatter

Mit Dioden kann man UND- und ODER-Gatter aufbauen (Abb. 4.1 bis 4.6). Zeitgemäße Anwendungen: elementare logische Verknüpfungen von Signalen, die keinen üblichen Logikpegeln entsprechen, z. B. in der Ebene der Feldverkabelung von Steuerungssystemen (vgl. Abb. 4.1) oder zur Implementierung von Sicherheitsfunktionen (die direkt – d. h. ohne Mikrocontroller, Software o. dergl. – wirken müssen).



Abbildung 5.1.1 Dioden-Gatterbaustein zum Einsatz in Steuerungssystemen (Weidmüller)

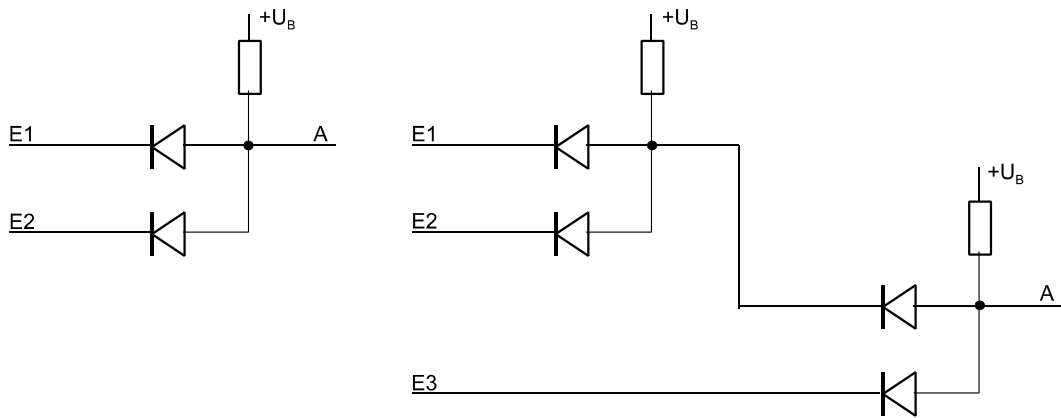


Abbildung 5.1.2 UND-Verknüpfung. Links ein einzelnes Gatter, rechts zwei Gatter hintereinander

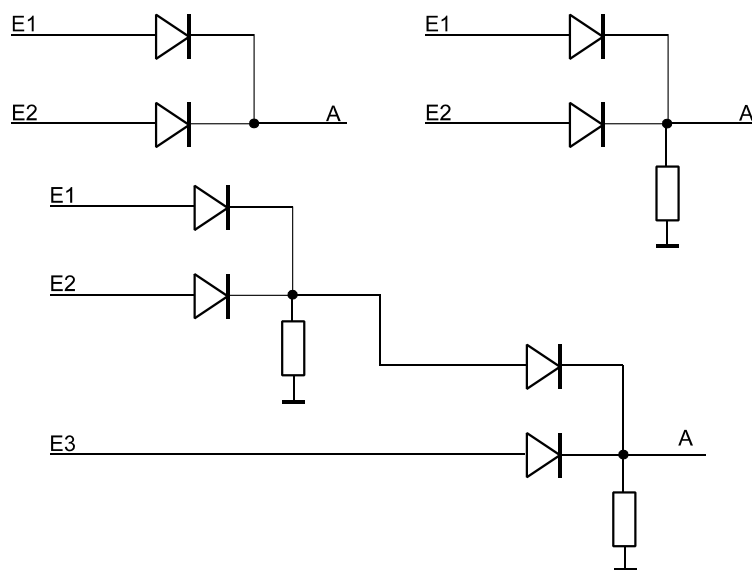


Abbildung 5.1.3 ODER-Verknüpfung. Oben einzelne Gatter, unten zwei Gatter hintereinander

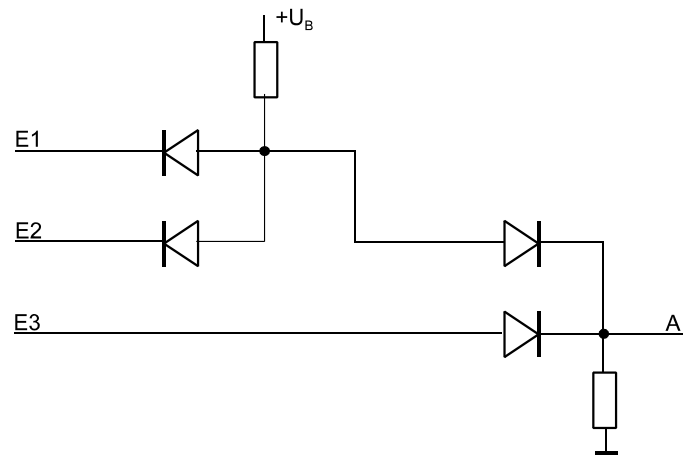


Abbildung 5.1.4 UND-ODER-Verknüpfung

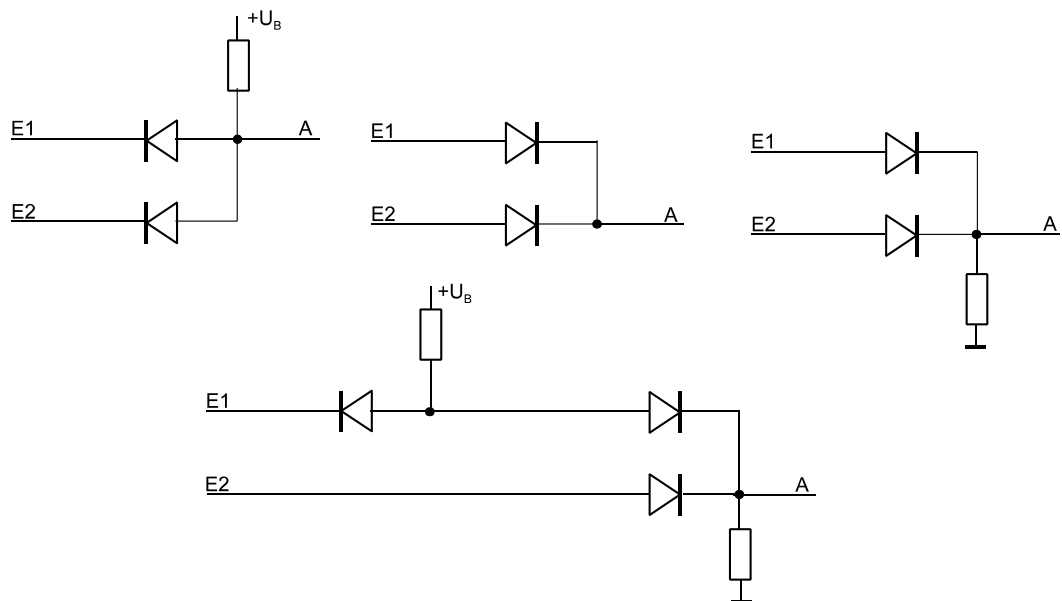


Abbildung 5.1.5 Versuchsschaltungen zur dynamischen Erprobung